

$$= U_r K_0 / (2\pi) \int_{-\infty}^{\infty} \left[\int_{-\infty}^{\infty} \exp [-j a (\omega - \omega_n)^2 + j \omega (t - \tau_0 - \lambda) + j \tau_0 \omega_n] d\omega \times \right. \\ \left. \times U_c (\lambda) \exp [j (\omega_c - \omega_r) \lambda + j \varphi_c - j \lambda^2 / (4a)] d\lambda \right]$$

Преобразуем внутренний интеграл подстановкой $\omega = x/\sqrt{a} + [2a\omega_n + (t - \tau_0 - \lambda)]/(2a)$; $d\omega = dx/\sqrt{a}$, тогда

$$u_{\text{вых}}(t) = U_r K_0 / (2\pi \sqrt{a}) \int_{-\infty}^{\infty} \left[\int_{-\infty}^{\infty} \exp (-j x^2) dx \right] \times \\ \times U_c (\lambda) \exp [j \omega_n (t - \lambda) + j (t - \tau_0 - \lambda)^2 / (4a) + \\ + j (\omega_c - \omega_r) \lambda + j \varphi_c - j \lambda^2 / (4a)] d\lambda.$$

Внутренний интеграл в квадратных скобках сводится к интегралу Френеля и равен $\sqrt{\pi/2} \cdot \exp(-j\pi/4)$ [2]. Тогда

$$u_{\text{вых}}(t) = U_r K_0 / (2 \sqrt{2\pi a}) \cdot \exp [j \omega_n t + j (t - \tau_0)^2 / (4a) - j \pi / 4] \times \\ \times \int_0^{\tau_{\text{ан}}} U_c (\lambda) \exp [j (\omega_c - \omega_r) \lambda + j \varphi_c - j \Omega \lambda] d\lambda,$$

где $\Omega = \Omega(t) = \omega_n + (t - \tau_0)/(2a)$.

Напряжение на выходе ДЛЗ — это колебание с огибающей, определяемой интегралом $\int_0^{\tau_{\text{ан}}} U_c (\lambda) \exp [j (\omega_c - \omega_r) \lambda + j \varphi_c - j \Omega \lambda] d\lambda = S(\Omega)$.

Такой интеграл является преобразованием Фурье радиоимпульса с огибающей $U_c(t)$ и заполнением по частоте $(\omega_c - \omega_r)$, т. е. спектральной функцией $S(\Omega)$ исследуемого участка реализации — радиоимпульса $e(t)$. Текущая частота Ω линейно связана со временем и изменение амплитуды напряжения на выходе ДЛЗ во времени характеризует спектральную функцию напряжения $e(t)$.

1. Гоноровский И. С. Радиотехнические цепи и сигналы. М.: Сов. радио, 1982. 568 с. 2. Двайт Г. Б. Таблицы интегралов и другие математические формулы / Под ред. К. А. Семендяева. М.: Наука, 1973. 210 с. 3. Хорунжий В. А., Долбня Е. В. Богатов П. И. Акустoeлектроника. Киев: Техніка, 1984. 150 с.

Поступила в редколлегию 11.04.84

УДК 621.3.012.8

В. С. ВУНТЕСМЕРИ, канд. техн. наук

МАТРИЦА РАССЕЯНИЯ ГЕЛИКОНОВОГО ВЕНТИЛЯ

Геликоновые вентили относятся к классу невзаимных пассивных устройств. Их невзаимные свойства проявляются в изменении передаточной функции при перемене местами подключенных генера-

тора и нагрузки. В работах [2, 3, 5] при определении коэффициента передачи использованы классически нормированные матрицы параметров $[Z]$ и $[Y]$, найденные на основе метода контурных токов и узловых напряжений.

Анализ цепей методом полюсов основан на волновой матрице рассеяния [4], широко применяемой в теории цепей с распределенными параметрами. Использование волновых матриц при анализе цепей с сосредоточенными параметрами позволяет проводить анализ по единой методике как в области низких, так и в области высоких частот. Особенно наглядно преимущества матрицы рассеяния проявляются при анализе невязанных устройств, поскольку сами элементы матрицы рассеяния представляют собой передаточные и входные функции исследуемого многополюсника.

Рассмотрим схему геликонового вентиля [3], состоящего из двух катушек индуктивности L_1 и L_2 , намотанных перпендикулярно друг другу на полупроводниковую пластину из антимолида индия n -типа толщиной $2d$ и конденсатора C . Вентиль подключен к источнику и нагрузке с помощью кабеля с волновым сопротивлением Z_0 . Обозначим через U_1^+ , U_1^- , U_2^+ , U_2^- нормированные волны напряжения падающих и отраженных волн на входах вентиля. Выберем значения индуктивностей $L_1 = L_2 = L_0$ и значения волновых сопротивлений линий передачи $Z_1 = Z_2 = Z_0$. Нормированные по отношению к Z_0 величины реактивных проводимостей $1/\omega L_0$ и ωC_0 обозначим соответственно через $y_L = Z_0/\omega L_0$ и $y_C = Z_0\omega C$. Тогда нормированная матрица $[Y]$ параметров вентиля может быть записана в виде

$$[Y] = \begin{bmatrix} iy_L \frac{\mu_{\parallel}}{\mu_{\parallel}^2 + \mu_{\perp}^2} + iy_C & y_L \frac{\mu_{\perp}}{\mu_{\parallel}^2 + \mu_{\perp}^2} - iy_C \\ -y_L \frac{\mu_{\perp}}{\mu_{\parallel}^2 + \mu_{\perp}^2} - iy_C & iy_L \frac{\mu_{\parallel}}{\mu_{\parallel}^2 + \mu_{\perp}^2} + iy_C \end{bmatrix}, \quad (1)$$

где $\mu_{\parallel} = \frac{1}{2} \left(\frac{\operatorname{tg} k_{-}d}{k_{-}} + \frac{\operatorname{tg} k_{+}d}{k_{+}} \right)$; $\mu_{\perp} = \frac{1}{2} \left(\frac{\operatorname{tg} k_{-}d}{k_{-}} - \frac{\operatorname{tg} k_{+}d}{k_{+}} \right)$; $k_{\pm}^2 =$

$$= \frac{\omega\mu_0}{\rho\sqrt{1+u^2}} e^{\pm \arctg \frac{1}{u}}; \quad u = \mu_n \beta_0; \quad i = \sqrt{-1}, \quad \rho - \text{сопротивление полупроводника}; \quad \mu_n - \text{подвижность электронов}; \quad B_0 - \text{индукция внешнего постоянного магнитного поля.}$$

Зная элементы матрицы $[Y]$, найдем волновую матрицу рассеяния $[S]$ по формуле преобразования матриц

$$[S] = ([I] - [Y]) \cdot ([I] + [Y])^{-1}. \quad (2)$$

Здесь $[I]$ — единичная матрица;

$$[S] = \frac{1}{D_V} \begin{bmatrix} 1 + y_L^2 \frac{\mu_{\parallel}^2 - \mu_{\perp}^2}{\mu_{\parallel}^2 + \mu_{\perp}^2} + -2y_L \frac{\mu_{\perp}}{\mu_{\parallel}^2 + \mu_{\perp}^2} + \\ + 2y_L y_C \frac{\mu_{\parallel}}{\mu_{\parallel}^2 + \mu_{\perp}^2} + i2y_C \\ 2y_L \frac{\mu_{\perp}}{\mu_{\parallel}^2 + \mu_{\perp}^2} + 1 + y_L^2 \frac{\mu_{\parallel}^2 - \mu_{\perp}^2}{\mu_{\parallel}^2 + \mu_{\perp}^2} + \\ + i2y_C + 2y_L y_C \frac{\mu_{\parallel}}{\mu_{\parallel}^2 + \mu_{\perp}^2} \end{bmatrix}, \quad (3)$$

где $D_V = 1 - y_L^2 \frac{\mu_{\parallel}^2 - \mu_{\perp}^2}{\mu_{\parallel}^2 + \mu_{\perp}^2} + i2y_L \frac{\mu_{\parallel}}{\mu_{\parallel}^2 + \mu_{\perp}^2} + i2y_C$.

Поскольку в матрице $[S]$ $S_{12} \neq S_{21}$, то рассматриваемый четырехполюсник является необратимым и может быть представлен в виде каскадного соединения обратимого четырехполюсника и идеального преобразователя мощности [1]. Условием согласования вентиля по входу и по выходу является равенство нулю S_{11} и S_{22} . Диагональные элементы матрицы рассеяния являются коэффициентами передачи вентиля в прямом (+) и обратном (-) направлениях

$$K^{\pm} = \frac{\pm 2y_L \mu_{\perp} + i2y_C (\mu_{\parallel}^2 + \mu_{\perp}^2)}{\mu_{\parallel}^2 + \mu_{\perp}^2 - y_L^2 (\mu_{\parallel}^2 - \mu_{\perp}^2) + i[2y_L \mu_{\parallel} + 2y_C (\mu_{\parallel}^2 + \mu_{\perp}^2)]}. \quad (4)$$

При оптимизации параметров вентиля добиваемся максимума K^+ и минимума K^- .

1. Зелях Э. В. Идеальный преобразователь мощности — новый элемент электронной цепи // Электросвязь. 1957. № 1. С. 35—47. 2. Красилич Г. П. Эквивалентная схема полупроводникового вентиля // Вестн. Киев. политехн. ин-та: Радиотехника. 1978. Вып. 15. С. 80—82. 3. Красилич Г. П. Полупроводниковый вентиль метрового диапазона волн // Изв. вузов. Радиотехника. 1976. 19, № 3. С. 122—123. 4. Ортюзи Ж. Теория электронных цепей. М.: Мир, 1976. 400 с. 5. Толутис Р. Б. О свойствах полупроводниковых ВЧ-вентилей на эффект размерного резонанса электромагнитных магнитоплазменных волн // Радиотехника и электроника. 1978. Т. 23, № 3. С. 608.

Поступила в редколлегию 17.09.84

УДК 621.374

Г. А. ГАЛИНА, мл. науч. сотр., Г. И. КАЛЬНАЯ,
С. В. ОГУРЦОВ, кандидаты физ.-мат. наук

ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ОСАЖДЕННЫХ МАГНЕТРОННЫМ РАСПЫЛЕНИЕМ ПЛЕНОК ZnO

Обработка технологии получения пленок ZnO для устройств функциональной электроники нами осуществлялась с привлечением рентгеновских и оптических исследований. Пленки окиси цинка толщиной до 6 мкм наносились на подложки из плавленого кварца маг-